

物理学基礎 II

講義 10,11 の板書ノート

電場に対する物質の応答

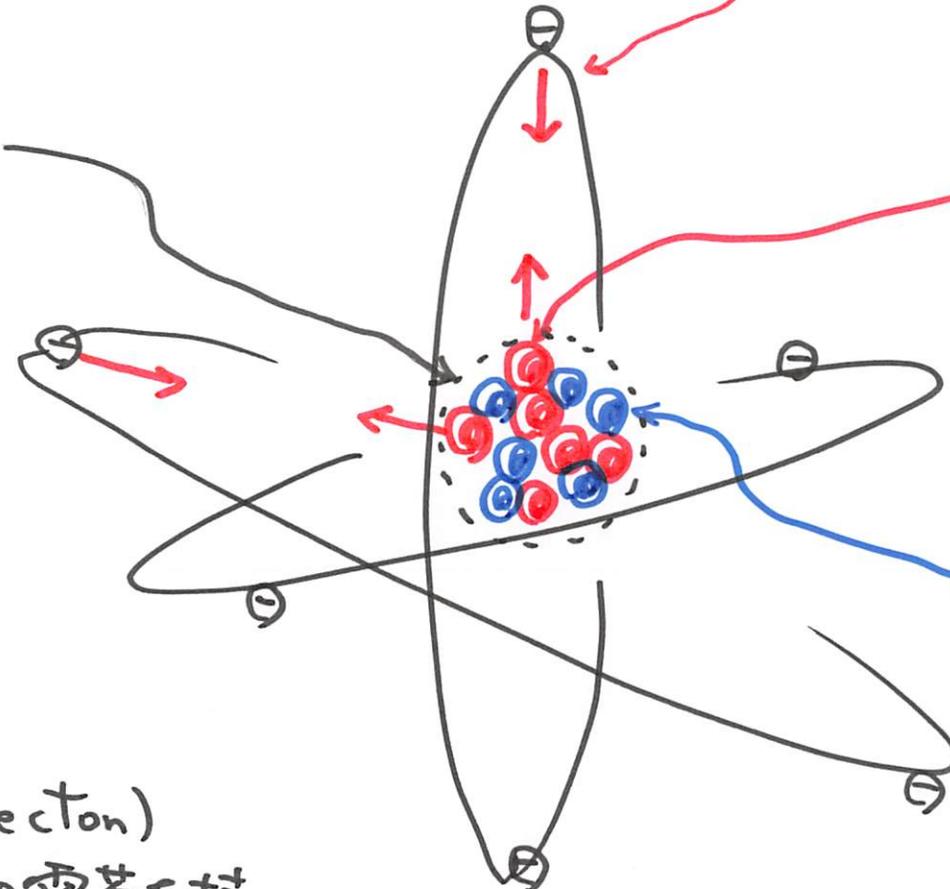
谷村 省吾

物質の構造は電気と深くかかち、ている。

例えば炭素原子(atom)

7-電子電場を引き合っている。

原子核
(nucleus)



陽子(proton)

プラスの電荷を持つ

$$e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$$

質量

$$m_p = 1.673 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

中性子(neutron)

電荷はゼロ

質量

$$m_n = 1.675 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

電子(electron)

マイナスの電荷を持つ

$$m_e = 9.109 \times 10^{-31} \text{ kg}$$

$$\frac{m_p}{m_e} = 1835$$

$$\frac{m_n}{m_e} = 1839$$

私たちの体には

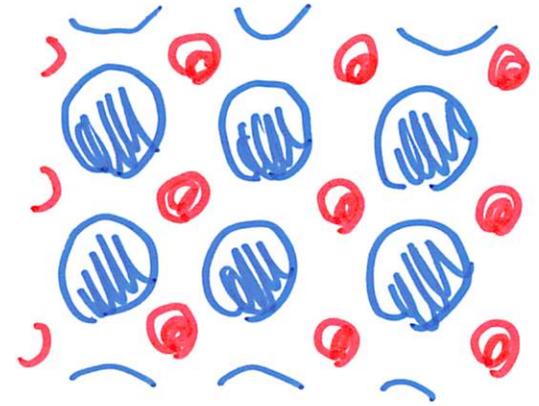
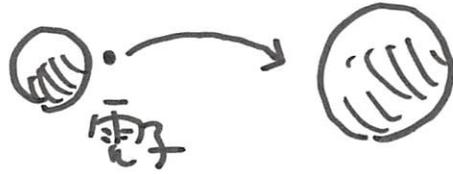
陽子の数 = 電子の数 \approx 中性子の数

なので体重の4000分の1くらいが電気の重さ。

体重60kgの人だと15gくらいが電子。

原子は電氣的に中性だが、電子が「取れた」り、余分に「ついたり」してイオン(帯電)になる。

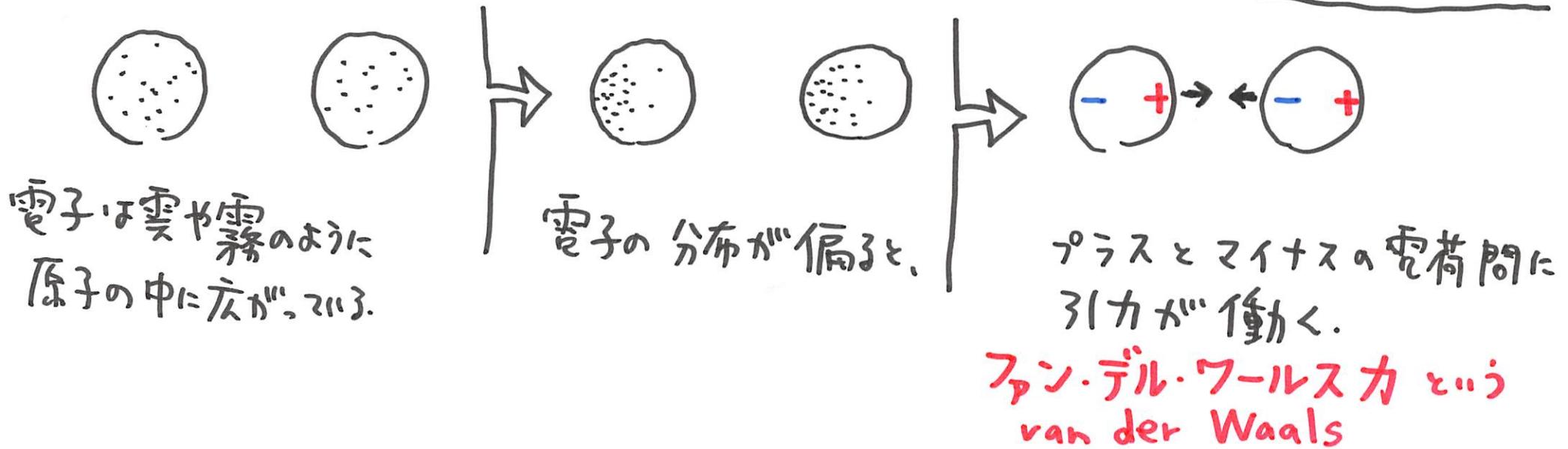
ナトリウム原子 塩素原子



原子の中で ^{の分布}電子が偏ることにより、

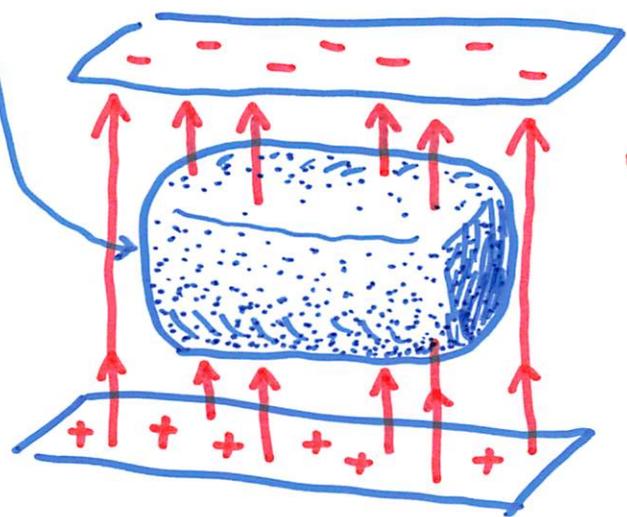
原子が分極電荷を持ち、原子間には力が働く。

くっついて整列する。
 塩化ナトリウム NaCl
 の結晶(食塩)



物質(固体・液体・気体)に電場を浴びせる (電場を印加する) apply electric field

と何が起こるか?

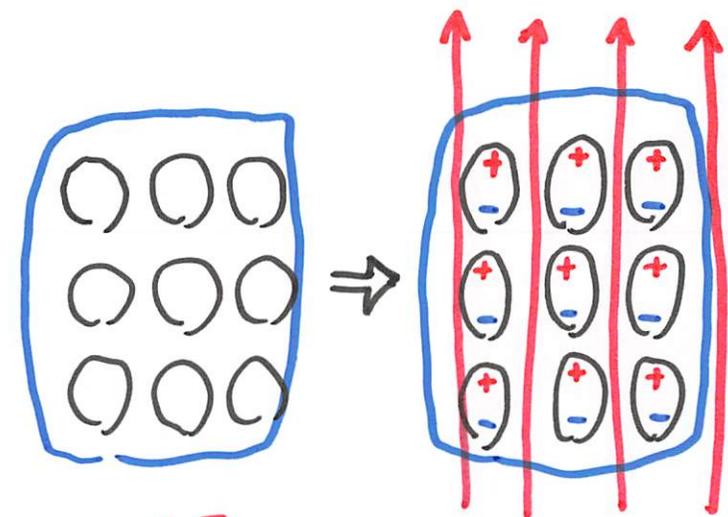
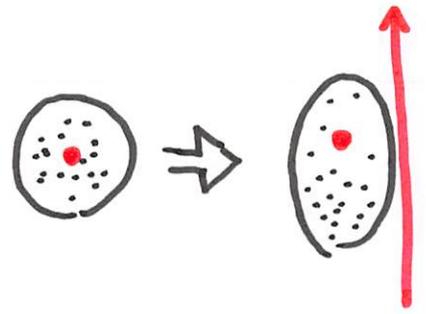


電場 E
外部からの場
external field. E

2通りの応答

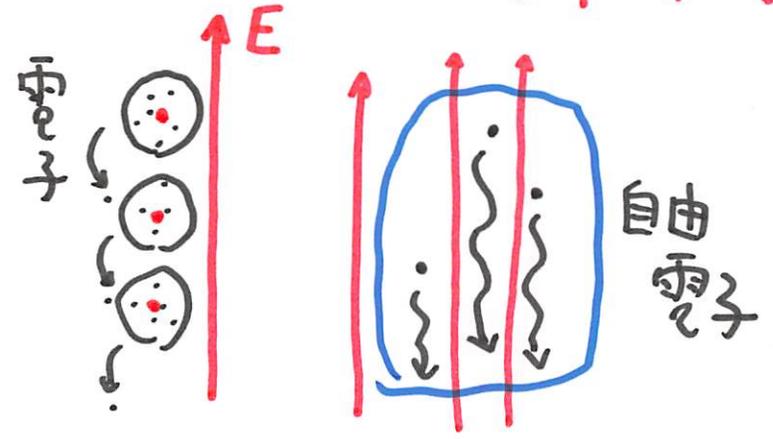
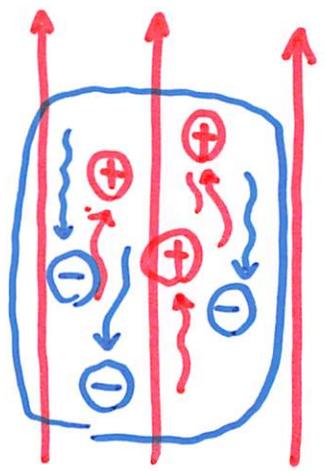
1. 誘電分極

原子・分子内で電子と原子核の
位置が少しずれて、
プラス・マイナスの分極を生じる。



2. 電流が流れる

正イオンは電場の方向に。
負イオンや電子は電場の逆方向に
引き寄せられ、際限なく移動し続ける。



物質の性質の分類

- 誘電体 (dielectric) ... 誘電分極を起こし得る物質
プラスチック, セラミックス, 油, 液晶など
- 導体 (conductor) ... 荷電粒子 (イオンや電子) が移動・通過し得る物質
= 良導体 ともいう。 銅, 銀, 塩酸, 水酸化ナトリウム水溶液など
- 導線 ... 導体 (たいていは金属) を細い線状の形状にしたもの。
電流を流すために使う。 
- 絶縁体 (insulator) ... 荷電粒子が通過しにくい物質。ほとんど電流が
= 不導体 ともいう。 流れない。 ガラス, ポリエステルなど。
ゴム
- 半導体 (semiconductor) ... 導体と絶縁体の中間的な物質。
不純物を混ぜたり, 外部から電場を与えたりすると電氣的性質が変り
ケイ素 (シリコン結晶) など やり得る。

電流の定量的表現

ある断面を時間 t の間に通過した電荷の量を Q とする。

t と Q が "比例関係にある"

$$Q = It$$

電流 I

の比例係数 I を電流の大きさと定める。

とくに、面積 S の断面を一樣な強度で電流が "流れていく"、

S に I は比例し、

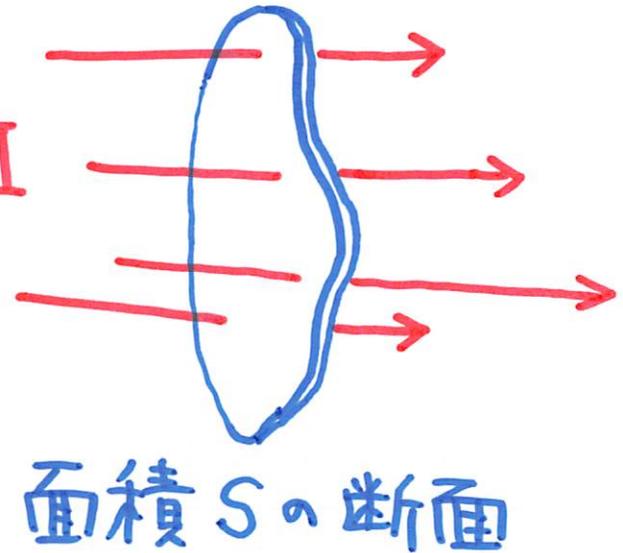
$$I = jS$$

の比例係数 j を電流密度と呼ぶ。

アンペア 7.0 毎秒

まとめ 電流 $I = \frac{Q}{t}$: 単位時間あたりの電荷の移動量. 単位は $A = C \cdot s^{-1}$

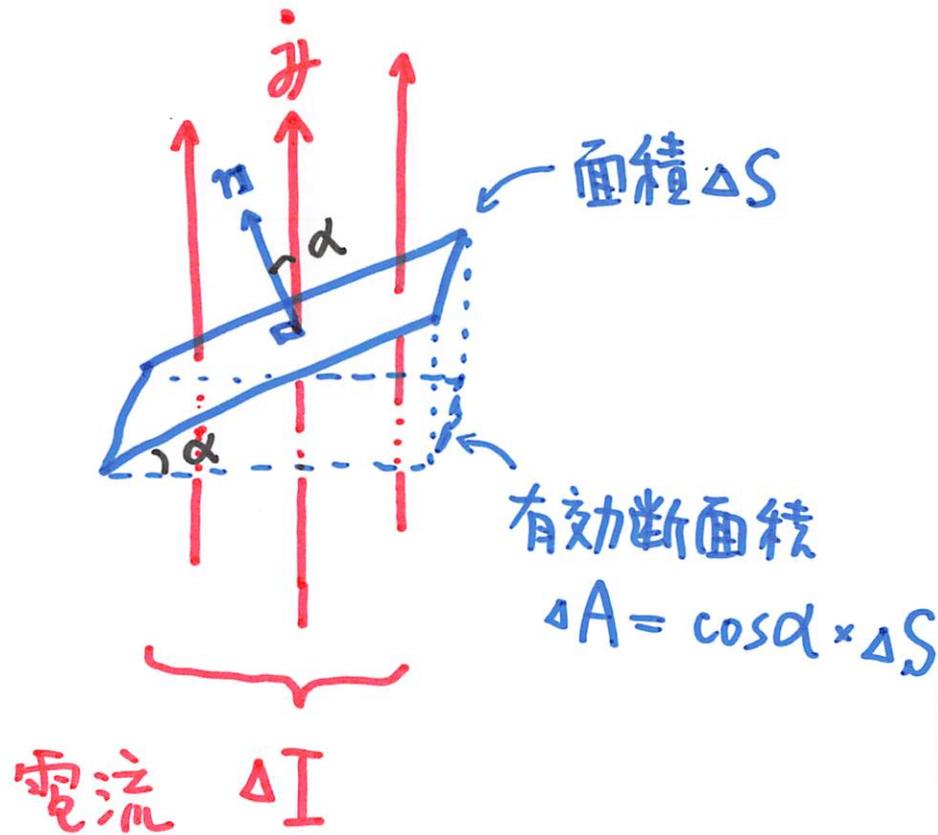
電流密度 $j = \frac{I}{S}$: 単位面積あたりの電流. 単位は $A \cdot m^{-2}$



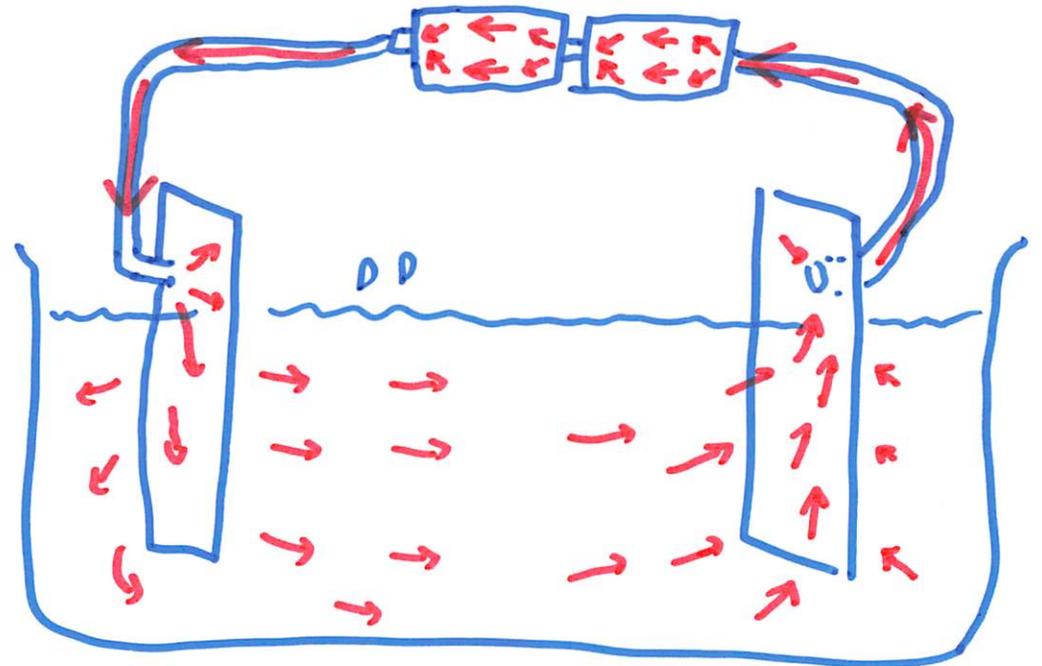
一般には、電流密度 $\mathbf{j}(r) = (j_x(x, y, z), j_y(x, y, z), j_z(x, y, z))$
 はベクトル場である。

単位法線ベクトル \mathbf{n} を持つ面積素片 ΔS を通過する電流は

$$\Delta I = \mathbf{j} \cdot \mathbf{n} \Delta S = \|\mathbf{j}\| \cos \alpha \times \Delta S$$



一般には電流密度は場所ごとに
 変化する。(時間的にも)



□-カルな電荷保存則

$\rho(r, t)$: 電荷密度

$\mathbf{j}(r, t)$: 電流密度

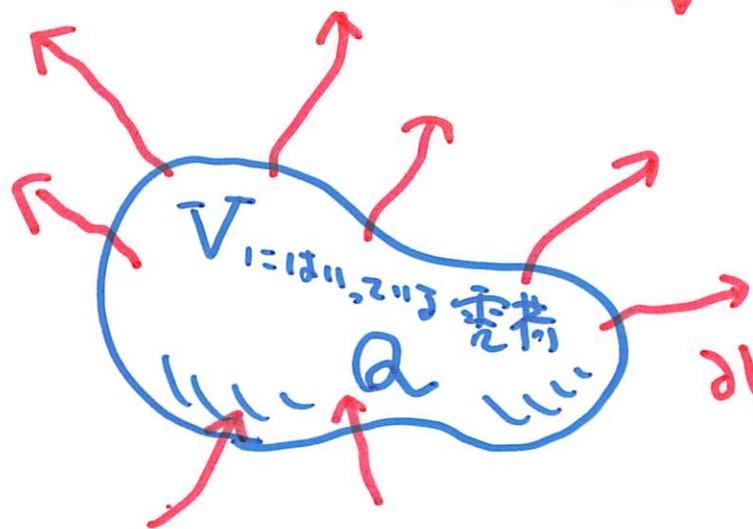
V : 任意の立体領域

(V 内の総電荷量の時間変化) $=$ $\overset{\text{マイナス}}{\downarrow}$ (V の表面を通過して流出する電流)

(増えればプラス, 減ればマイナス)

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_V \rho dV = - \int_{\partial V} \mathbf{j} \cdot \mathbf{n} dS$$

$$\frac{\partial Q}{\partial t} = -I$$



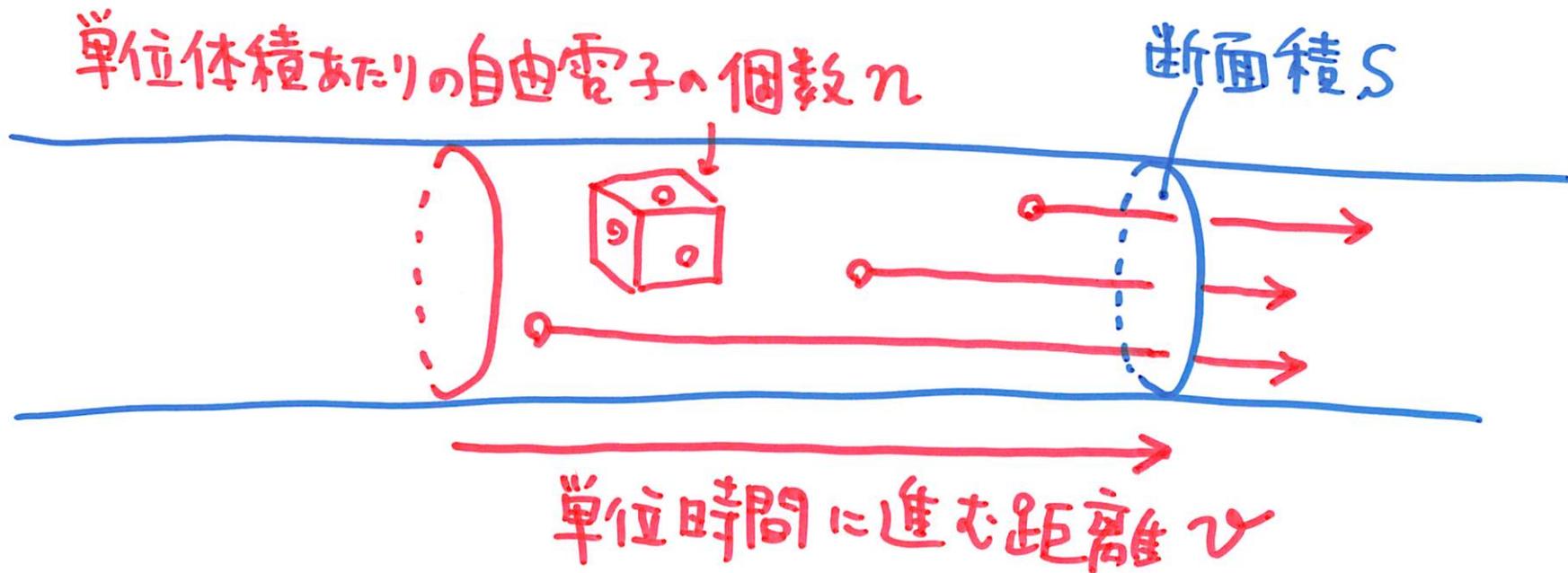
∂V を通過して流れ出る
正味の電流 I

電子の個数・密度・速度と電流の関係.

単位体積あたりの自由電子 (free electron; 原子に束縛されずに
固体中を動き回ることが出来る電子) の個数を n ,

電子の電荷を e , 電子の平均速度を v , 導線の断面積を S

とすると, 電流は $I = envS$



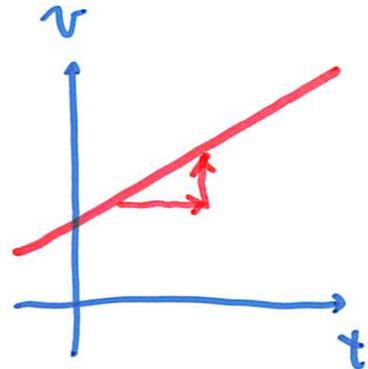
電場に対する電流応答.

質量 m , 電荷 q の粒子が電場 E から受ける力 $F = qE$

粒子の運動方程式 $m \frac{dv}{dt} = F = qE$

(v は時刻 t での速度)

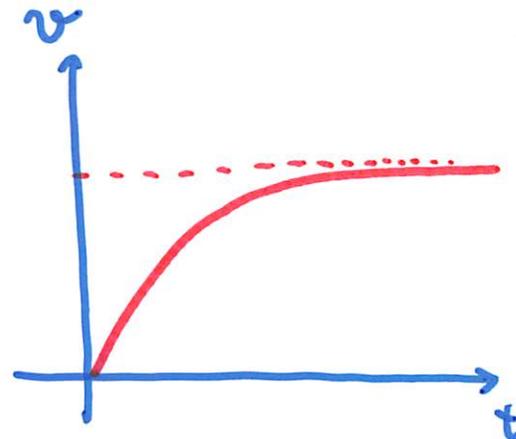
E が一定なら 解は $v(t) = v(0) + \frac{q}{m} E t$



... 荷電粒子の速度は無~~限~~際限なく大きくなり、
電流も際限なく増えそうなものだが、
現実の物質では v は一定の値に落ち着く。

しかも ~~終止~~ 収束速度 v は E に比例する。

ゆえに電流は E に比例する。



なぜか? 理由はけっこう難しい.

オームの法則 (Ohm's law)

電場 E を印加された物質中を流れる電流の密度は、

$$\vec{j} = \sigma E$$

シグマ

σ : 電気伝導率 (electrical conductivity)

①

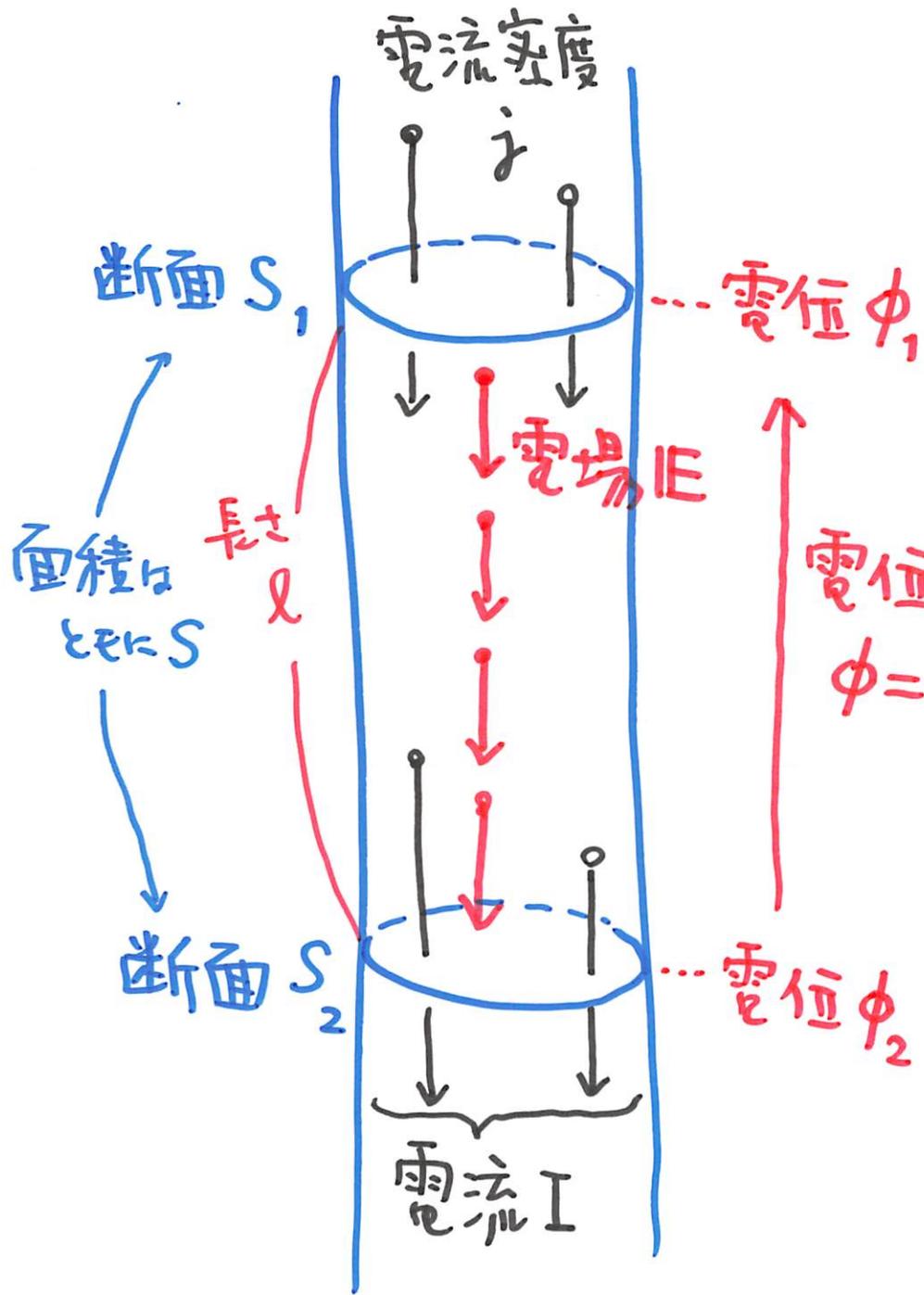
オームの法則は近似的・現象論的・経験則である。

つまり、なぜオームの法則が成り立つのか、という根拠はあまりない。絶対に正しい法則でもない。極端に電場を強くと、「電流は電場に比例する」という性質が成り立たなくなる。

σ の値は物質の種類によって異なる。 σ は「電流の通しやすさ」を表している。

$\rho = \frac{1}{\sigma}$: 電気抵抗率 (electrical resistivity)

ρ は「電流の通いにくさ」を表す。



電流密度 j の定義より $I = j \cdot S \dots ①$

オームの法則より $j = \sigma E \dots ②$

電位の定義より $\phi = E \cdot l \dots ③$

以上より

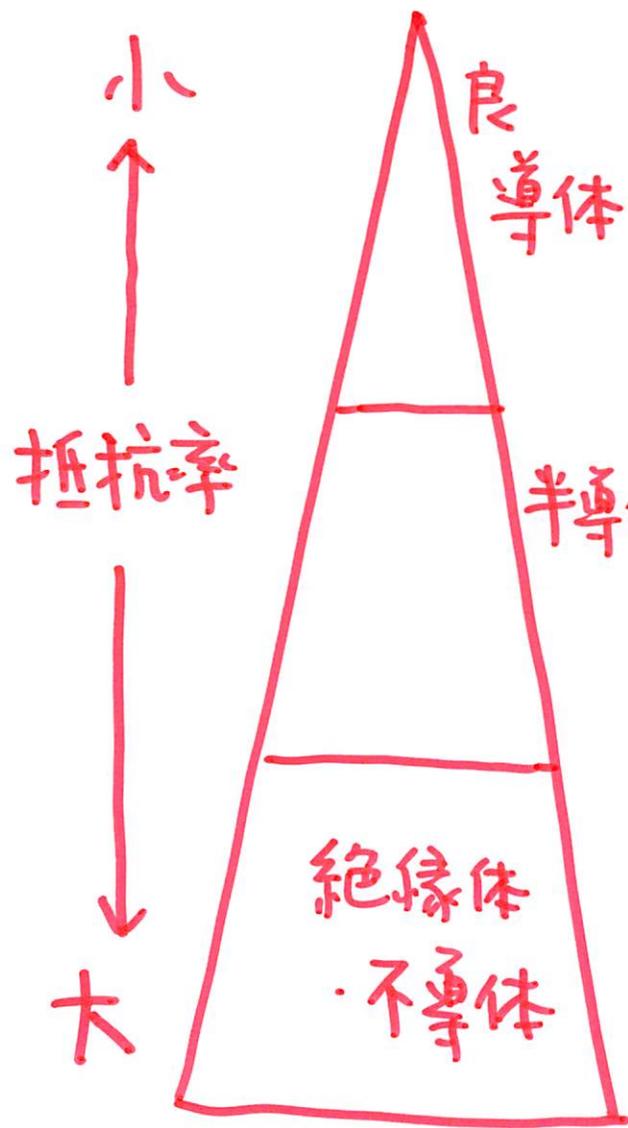
$$\begin{aligned} \phi &= l \cdot E \\ &= \frac{l}{\sigma S} \cdot \sigma E \cdot S \\ &= R \cdot jS \\ &= R \cdot I \end{aligned}$$

電気抵抗 $R := \frac{l}{\sigma S} = \frac{l}{S} \rho$

単位は Ω (オーム) (大文字のオメガ)

いろいろな物質の抵抗率 ρ

電流が流しやすい.



電流通いにくい

銀
銅
金
鉄

$$\rho = 1.47 \times 10^{-8} \Omega m$$

$$1.55 \times 10^{-8} \Omega m$$

$$2.05 \times 10^{-8}$$

$$8.9 \times 10^{-8}$$

半導体

炭素
海水
シリコン結晶

$$1640 \times 10^{-8} \Omega m$$

$$0.2 \Omega m$$

$$3970. \Omega m$$

絶縁体
不導体

ガラス
ポリエステル
硫黄
" おう

$$10^{10} \sim 10^{14} \Omega m$$

$$10^{12} \sim 10^{14}$$

$$2 \times 10^{15}$$

10^{23}
倍

導体を電場に置くと、

電場があるとオームの法則 $j = \sigma E$ により電流が流れる。

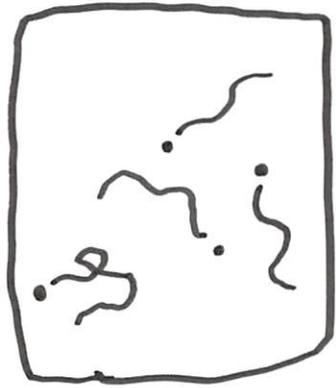
(自由電子が移動する)

電場がゼロでない限り電流は流れる。

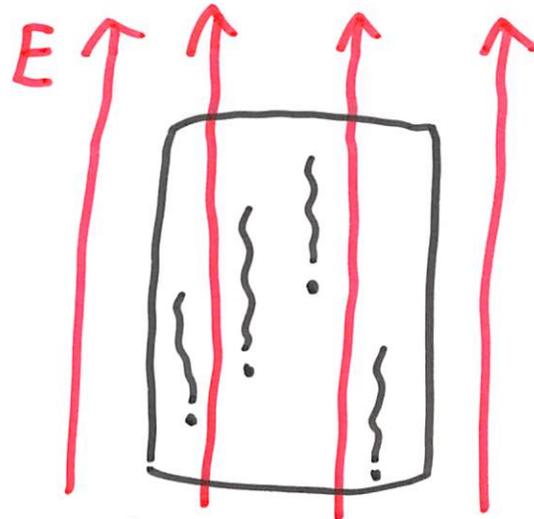
導体の外に自由電子は飛び出せず、電子が行き止まりの状態になる。

導体の表面にたまった電荷が作る電場が、導体の内部で、もともとあった電場と打ち消すと、電流も止まり、定常状態になる。

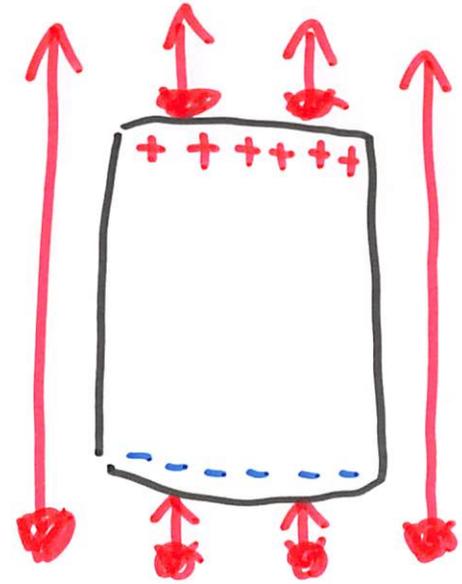
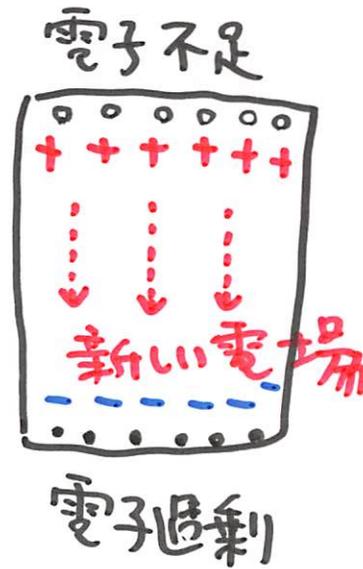
導体



自由電子がフラフラしている。



外から電場を印加すると、すぐ電子が動き出す。



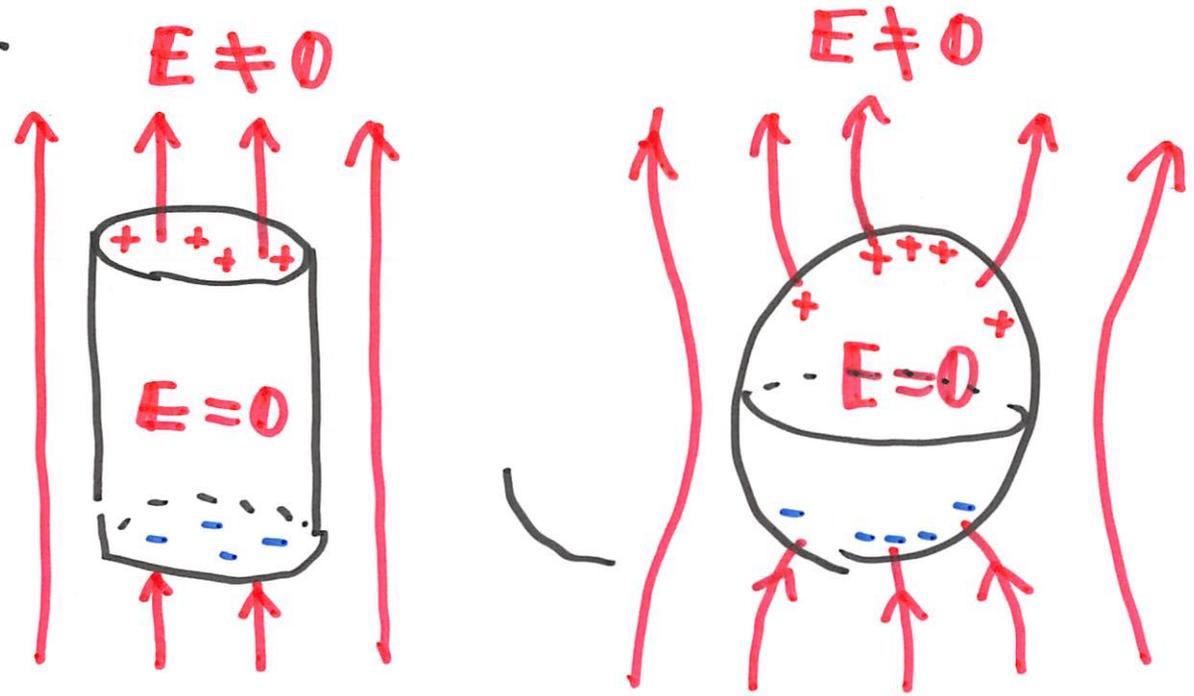
定常状態

静電場中に置かれた導体で成り立つこと。

定理1. 静電場中の定常状態の導体の内部の電場はゼロである。

なぜなら、もしも電場がノンゼロなら、電流が流れる。
定常状態じゃないから。

導体がどんな形であらうとも
導体内部は $E=0$ になる。



定理2. ひとつながりの導体の内部と表面の電位は等しい。
 とくに導体の表面は等電位面である。

なぜなら点 P_0 を基準とすると点 P の電位は $\phi(P) = - \int_{P_0}^P \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r}$ であり、
 2点 P, Q の電位差は

$$\phi(Q) - \phi(P) = - \int_P^Q \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r}$$

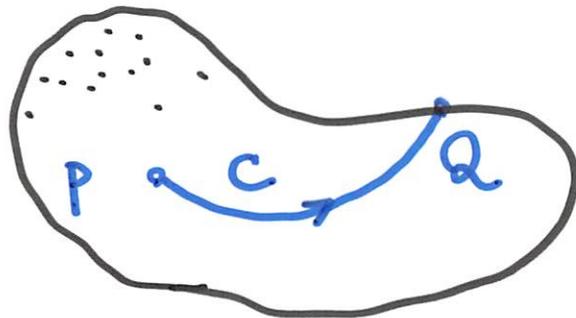
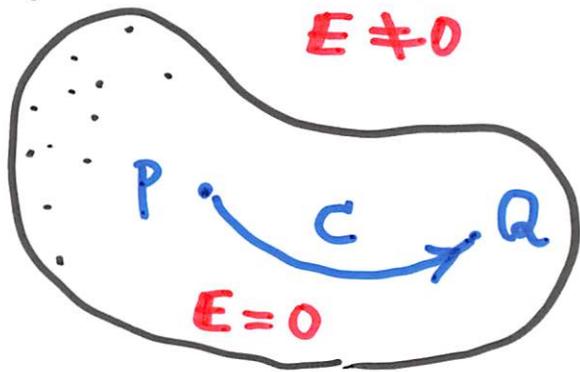
に等しい。 P から Q に向かう曲線 C を導体内部に選ぶことができるら、
 その線 ~~上~~ ^上 $\mathbf{E} = 0$ であり、 $\phi(Q) - \phi(P) = 0$ 。

導体

外では
 $\mathbf{E} \neq 0$

すなわち、

$$\phi(Q) = \phi(P)$$



定理3. 定常状態の導体の内部は電氣的に中性であり、
導体の電荷分布の偏りがあるとしても電荷は導体表面のみ
にたまる。

なぜなら点Pが導体内部の点なら、立体領域Vを、点Pを含み、

V自体が導体内部におさまるようにVを選ぶことができる。

このVにガウスの法則を適用すると、 ∂V は導体内なのでここで $E=0$ であり、

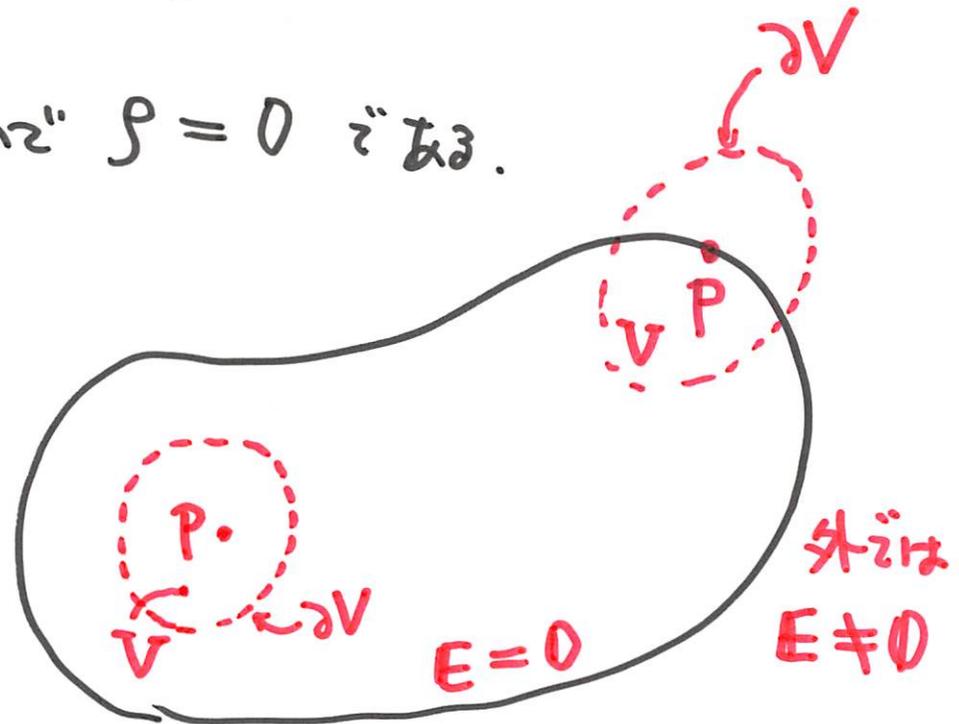
$$\int_V \rho dV = \epsilon_0 \int_{\partial V} \mathbf{E} \cdot \mathbf{n} dS = 0$$

領域Vをいくら小さくしてもこれが言えるので $\rho=0$ である。

点Pが導体の表面にあると、

Pを含む領域Vをどう選んでも

表~~面~~境界 ∂V の一部が導体の外に出る
しうので、 ∂V 上で $E=0$ とは言えない。



定理4. 導体の表面のすぐ外の電場は必ず導体表面に垂直であり、導体表面の電荷密度を σ とすると、すぐ外の電場の強さは $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$ に等しい。

なぜなら、今回の定理2で導体表面は等電位面であることがわかる。テキスト7で電位の幾何学的性質として、等電位面と電場ベクトルは直交することを示した。よって導体表面と電場は直交する。

また、表面のすぐ近傍に、高さ $2h$ 、底面積 S の微小な柱形領域 V を、高さ h は導体内部に、残り的高さ h は導体外部に出るように「選んじ」

ガウスの法則を適用すると、

$$\epsilon_0 E \cdot S = \sigma \cdot S$$

となるので

$$E = \frac{\sigma S}{\epsilon_0 S} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

